

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-337436

(43)Date of publication of application : 06.12.1994

(51)Int.Cl.

G02F 1/136
H01L 29/784

(21)Application number : 05-125577

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 27.05.1993

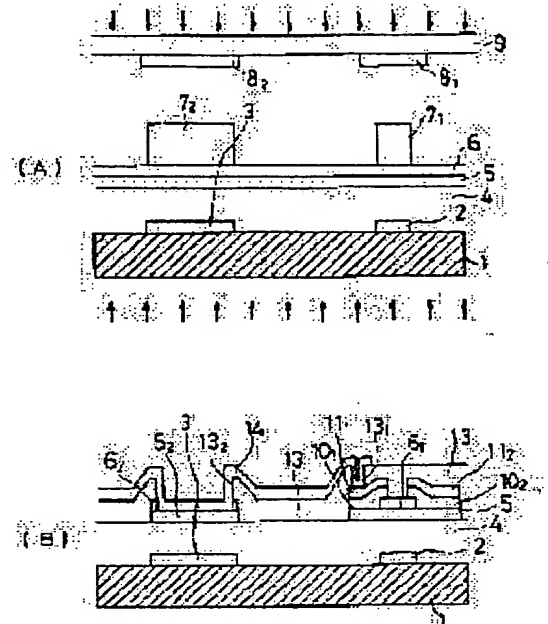
(72)Inventor : INOUE ATSUSHI

(54) MANUFACTURE OF THIN FILM TRANSISTOR MATRIX

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a manufacturing method of a thin film transistor matrix by which nonuniformity of liquid crystal display is not caused in the manufacturing method of the thin film transistor matrix.

CONSTITUTION: In a manufacturing method of a thin film transistor matrix having a gate electrode 2, a source electrode 111, a drain electrode 112, a picture element electrode, a storage capacitor electrode 3 and a bus line connected to these, a semiconductor film 52 to form an active layer is left on a gate insulating film 4 on this storage capacitor electrode 3 by leaving a photoresist film 71 used in a process to form a channel protective film 61 of a thin film transistor also on the storage capacitor electrode 3 as a photoresist film 72, and this semiconductor film 52 is used as an etching stopper when a contact hole 132 to form a storage capacitor is formed by etching a protective film 13 formed on this semiconductor film 52.



Japanese Laid-Open Patent Publication No. 6-337436/1994
(Tokukaihei 6-337436) (Published on December 6, 1994)

(A) Relevance to claim

The following is a translation of passages related to claims 1, 7, 8, 10, and 11 of the present invention.

(B) Translation of the relevant passages.

(57) [Abstract]

[Constitution] ... a semiconductor film 5₂, which will be fabricated into an active layer, is left on the gate insulating film 4 on this storage capacitor electrode 3. The semiconductor film 5₂ is then used as an etching stopper when the protection film 13 provided on the semiconductor film 5₂ is etched to form a contact hole 13₂ in which a storage capacitor will be provided.

[Claim]

[Claim 1] A method of manufacturing a thin film transistor matrix including a gate electrode, a source electrode, a drain electrode, a pixel electrode, a storage capacitor electrode, and bus line connected to the electrodes, being characterized in that:

a semiconductor film, which will be fabricated into an active layer, is left on a gate insulating film on a storage capacitor electrode by leaving on the storage capacitor electrode a photoresist film used in a step of forming a channel protection film of a thin film transistor; and

the semiconductor film is then used as an etching stopper when a protection film provided on the semiconductor film is etched to form a contact hole in which an opposite electrode of a storage capacitor will be provided.

[0016]

[Means to Solve the Problems] ... a semiconductor film, which will be fabricated into an active layer, is left on the gate insulating film on the storage capacitor electrode. The semiconductor film is then used as an etching stopper when the protection film provided on the semiconductor film is etched to form a contact hole in which an opposite electrode of a storage capacitor will be provided.

[0020] ... a layered body constituted by an a-Si film 5₂ and a SiN film 6₂ is provided on the storage capacitor

electrode 3.

[0021] A SiN film 13, acting as a protection layer, is provided covering the whole top of the layered body. Through the SiN film 13 are provided a contact hole 13₁ forming a passage to the source electrode 11₁ and a contact hole 13₂ forming a passage to the a-Si film 5₂ on the storage capacitor electrode 3. An ITO film 14 is provided on top of it and etched into a pattern to form pixel electrodes on the storage capacitor electrodes 3 and wiring connecting the pixel electrodes to the source electrodes 11₁.

[0022] ... the a-Si film 5₂ acts an etching stopper when the contact hole 13₂ is formed on the storage capacitor electrodes 3 by etching and thereby prevents excessive etching of the gate insulating film 4. Thus, film thickness is controlled better.

[0030] The n⁺ a-Si film 10 and the a-Si film 5 are sequentially etched by plasma, using the second resist films 12₁ and 12₂ formed in the fifth step as masks, to form an a-Si film 5₁ that is a semiconductor active layer, n⁺ a-Si films 10₁ and 10₂ that are an ohmic contact layers, a source electrode 11₁, and a drain electrode 11₂ on the SiN film 4 that is a gate insulating film and also form

a layered body constituted by an a-Si film 5₂ and a SiN film 6₂ on the storage capacitor electrode 3.

[0031] A SiN film 13 is provided by P-CVD as a protection film on the entire surface of the SiN film 4 including the source electrode 11₁ and the drain electrode 11₂, as well as the layered body constituted by an a-Si film 5₂ and a SiN film 6₂ on the storage capacitor electrode 3, all electrodes and films being formed in the sixth step. The SiN film 13 is then selectively etched to form a contact hole 13₁ forming a passage to the source electrode 11₁ and a contact hole 13₂ forming a passage to the a-Si film 5₂ on the storage capacitor electrode 3. In this step, the a-Si film 5₂ acts as an etching stopper when the contact hole 13₂ etched out on the storage capacitor electrode 3.

[Reference Numerals]

5₂: a-Si film

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-337436

(43) 公開日 平成6年(1994)12月6日

(51) Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 F 1/136	5 0 0	9119-2K		
H 0 1 L 29/784		9056-4M	H 0 1 L 29/ 78	3 1 1 A

審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平5-125577

(22) 出願日 平成5年(1993)5月27日

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72) 発明者 井上 淳

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74) 代理人 弁理士 柏谷 昭司 (外1名)

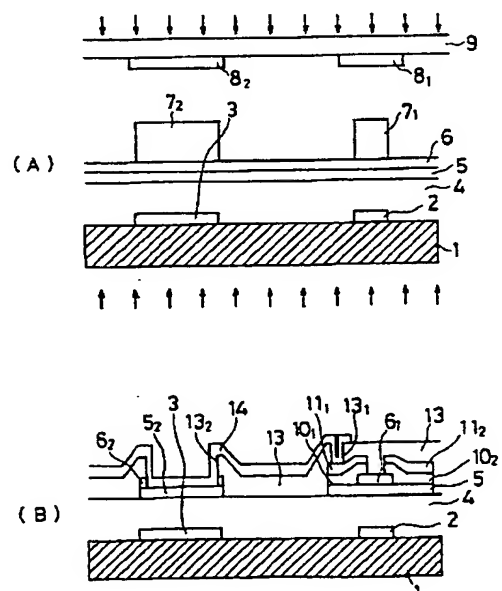
(54) 【発明の名称】 薄膜トランジスタマトリクス製造方法

(57) 【要約】

【目的】 薄膜トランジスタマトリクスの製造方法に関し、液晶表示むらがない薄膜トランジスタマトリクスの製造方法を提供する。

【構成】 ゲート電極2、ソース電極11₁、ドレイン電極11₂、画素電極、ストレージキャパシタ電極3およびそれらに接続されるバスラインを有する薄膜トランジスタマトリクスの製造方法において、薄膜トランジスタのチャネル保護膜6₁を形成する工程で用いるフォトレジスト膜7₁をストレージキャパシタ電極3の上にもフォトレジスト膜7₂として残すことによって、このストレージキャパシタ電極3の上のゲート絶縁膜4の上に活性層を形成するための半導体膜5₂を残しておき、この半導体膜5₂を、この半導体膜5₂の上に形成される保護膜13をエッチングして、ストレージキャパシタを形成するためのコンタクトホール13₂をエッチングによって形成する際のエッチングストッパーとする。

本発明の薄膜トランジスタマトリクスの製造方法の原理説明図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、画素電極、ストレージキャパシタ電極およびそれらに接続されるバスラインを有する薄膜トランジスタマトリクス of 製造方法において、薄膜トランジスタのチャネル保護膜を形成する工程で用いるフォトレジスト膜を該ストレージキャパシタ電極の上に残すことによって、該ストレージキャパシタ電極の上のゲート絶縁膜の上に活性層を形成するための半導体膜を残しておく、該半導体膜を、該半導体膜の上に形成される保護膜をエッチングして該ストレージキャパシタの対向電極を形成するためのコンタクトホールをエッチングによって形成する際のエッチングストッパーとすることを特徴とする薄膜トランジスタマトリクスの製造方法。

【請求項2】 薄膜トランジスタのチャネル保護膜を形成する工程で用いるフォトレジスト膜をストレージキャパシタ電極上に残す方法として、該ストレージキャパシタ電極を露光マスクとして該フォトレジスト膜を露光することを特徴とする請求項1に記載された薄膜トランジスタマトリクスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、液晶表示装置等に用いる、薄膜トランジスタマトリクスの製造方法に関する。近年、液晶表示装置を情報処理装置の表示装置、TVの表示装置として用いられ、大面積化、精細化することが望まれているが、表示むらが発生しない製造方法を開発することが要求されている。

【0002】

【従来の技術】 図5は、従来の薄膜トランジスタマトリクスのTFT基板の平面図である。この図において、21はゲートバスライン、22はゲート電極、23はドレインバスライン、24はドレイン電極、25はソース電極、26は画素電極、27はコンタクトホール、28はストレージキャパシタバスラインである。

【0003】 従来の薄膜トランジスタマトリクスは、この図にその平面が示されているように、透明基板の上にゲートバスライン21に接続されたゲート電極22が形成され、その上にゲート絶縁膜、活性層となる半導体膜、チャネル保護膜が形成され、その上にドレインバスライン23に接続されたドレイン電極24とソース電極25、オーミックコンタクト層が形成され、このソース電極25にコンタクトホール27によって接続された画素電極26が形成され、ゲート電極22とドレイン電極24とソース電極25によって薄膜トランジスタが構成されている。なお、この従来の薄膜トランジスタマトリクスには、画素電極26の中にストレージキャパシタ

(Cs) バスライン28が形成されている。なお、この薄膜トランジスタマトリクスの断面については後に製造方法とともに説明する。

【0004】 そして、このTFT基板と、対向電極、あるいは、対向電極とカラーフィルタを有する対向基板を間隔をおいて平行に配置し、この間隔中に液晶を注入して液晶表示装置が形成される。

【0005】 図6、図7、図8は、従来の薄膜トランジスタマトリクスの製造工程説明図であり、(A)～

(H) は各工程を示している。この図は、図5のX-X' 上の断面 (図面の符号は異なる) を示している。この図において、31は透明なガラス基板、32はゲート電極、33はストレージキャパシタ電極、34はSiN膜、35はa-Si膜、35₁はa-Si膜、36はSiN膜、36₁はチャネル保護膜、37は第1のレジスト膜、38は遮光膜、39は露光マスク、40はn⁺a-Si膜、40₁、40₂はn⁺a-Si膜、41はCr膜、41₁はソース電極、41₂はドレイン電極、42₁、42₂は第2のレジスト膜、43はSiN膜、43₁、43₂はコンタクトホール、44はITO膜である。この製造工程説明図によって従来の薄膜トランジスタマトリクスの製造方法を説明する。

【0006】 第1工程 (図6 (A) 参照)

透明なガラス基板31の上の全面に、Al膜とTi膜を連続して形成し、このAl/Ti膜をパターニングしてゲート電極32とゲートバスライン (以下「ゲート電極32」で代表させる)、ストレージキャパシタ電極33、ストレージキャパシタバスライン (以下「ストレージキャパシタ電極33」で代表させる) を形成する。

【0007】 第2工程 (図6 (B) 参照)

その上の全面に、P-CVDによって、ゲート絶縁膜となる厚さ400nmのSiN膜34、半導体活性層となる厚さ10nmのa-Si膜35、チャネル保護膜となる厚さ10nmのSiN膜36を連続的に形成する。

【0008】 第3工程 (図6 (C) 参照)

第2工程で形成したSiN膜34、a-Si膜35、SiN膜36の上にフォトレジスト膜を形成し、このフォトレジスト膜を、ガラス基板31の下方からゲート電極32とストレージキャパシタ電極33をマスクにして背面露光し、また、ガラス基板31の上から、ゲート電極32の上方に遮光膜38を有する露光マスク39をマスクにして正面露光して、現像することによってゲート電極32にセルフアラインして第1のレジスト膜37を残す。

【0009】 第4工程 (図7 (D) 参照)

第3工程で形成した第1のフォトレジスト膜37をマスクにしてSiN膜36を選択的にエッチング除去してチャネル保護膜36₁を形成する。その上に、オーミックコンタクト層となるn⁺a-Si膜40、ソース電極とドレイン電極となるCr膜41を順次形成する。

【0010】 第5工程 (図7 (E) 参照)

第4工程で形成したn⁺a-Si膜40、Cr膜41の上の全面にフォトレジスト膜を形成し、ソース電極とド

レイン電極の形状にパターニングした第2のレジスト膜42₁、42₂を残す。

【0011】第6工程(図7(F)参照)

第5工程で形成した第2のレジスト膜42₁、42₂をマスクにしてプラズマエッチングによって、Cr膜41とn⁺a-Si膜40とa-Si膜35を順次エッチング除去して、ゲート絶縁膜であるSiN膜34の上に、半導体活性層であるa-Si膜35₁、オーミックコンタクト層であるn⁺a-Si膜40₁、40₂、ソース電極41₁とドレイン電極41₂を形成する。

【0012】第7工程(図8(G)参照)

第6工程で形成したソース電極41₁とドレイン電極41₂を含むSiN膜34の全面に保護膜となるSiN膜43をP-CVDによって形成し、このSiN膜43を選択的にエッチングしてソース電極41₁に達するコンタクトホール43₁と、ストレージキャパシタ電極33上のSiN膜34に達するコンタクトホール43₂を形成する。

【0013】第8工程(図8(H)参照)

第7工程で形成したコンタクトホール43₁、43₂を含むSiN膜43の全面にITO膜44をスパッタによって形成し、パターニングすることによってストレージキャパシタ電極33の上に透明な画素電極を形成し、画素電極とソース電極41₁を接続する配線を形成する。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】上記の従来技術で問題となる点は、第7工程において、保護膜となるSiN膜43を形成した後、ストレージキャパシタ33の上にコンタクトホール43₂を形成する時に、保護膜とゲート絶縁膜がともにSiN膜34、43で、エッチングレートが同じであるため、ストレージキャパシタの誘電体とするSiN膜34の膜厚を所定の値に制御することが困難である。

【0015】ストレージキャパシタの誘電体とするSiN膜34の膜厚にばらつきを生じると、液晶表示面内でストレージキャパシタの容量むらが生じ、そのため表示のむらを生じるため、表示品質が著しく劣化するという問題がある。本発明は、液晶表示むらが無い薄膜トランジスタマトリクス of 製造方法を提供することを目的とする。

【0016】

【課題を解決するための手段】本発明にかかる薄膜トランジスタマトリクス of 製造方法においては、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、画素電極、ストレージキャパシタ電極およびそれらに接続されるバスラインを有する薄膜トランジスタマトリクス of 製造方法において、薄膜トランジスタのチャネル保護膜を形成する工程で用いるフォトレジスト膜を該ストレージキャパシタ電極の上に残すことによって該ストレージキャパシタ電極の上のゲート絶縁膜の上に活性層を形成するための半導

体膜を残しておき、該半導体膜を、該半導体膜の上に形成される保護膜をエッチングして該ストレージキャパシタの対向電極を形成するためのコンタクトホールをエッチングによって形成する際のエッチングストップとす工程を採用した。

【0017】この場合、薄膜トランジスタのチャネル保護膜を形成する工程で用いるフォトレジスト膜をストレージキャパシタ電極上に残す方法として、該ストレージキャパシタ電極を露光マスクとして該フォトレジスト膜を露光することができる。

【0018】

【作用】図1は、本発明の薄膜トランジスタマトリクス of 製造方法の原理説明図であり、(A)と(B)は各工程を示している。この図において、1は透明なガラス基板、2はゲート電極、3はストレージキャパシタ電極、4はSiN膜、5はa-Si膜、5₁、5₂はa-Si膜、6はSiN膜、6₁はSiN膜、7₁、7₂は第1のレジスト膜、8₁、8₂は遮光膜、9は露光マスク、6₁はチャネル保護膜、10₁、10₂はn⁺a-Si膜、11₁はソース電極、11₂はドレイン電極、13はSiN膜、13₁、13₂はコンタクトホール、14はITO膜である。この製造工程説明図によって本発明の薄膜トランジスタ of 製造方法の原理を説明する。

【0019】第1工程(図1(A)参照)

ガラス基板1の上にゲート電極2とストレージキャパシタ電極3を形成し、その上にSiN膜4、a-Si膜5、SiN膜6を連続的に形成する。その上に、フォトレジスト膜を形成し、このフォトレジスト膜を、ガラス基板1の下方からゲート電極2とストレージキャパシタ電極3をマスクにして背面露光し、また、ガラス基板1の上から、ゲート電極2の上とストレージキャパシタ電極3の上方に遮光膜8₁、8₂を有する露光マスク9を用いて正面露光し、現像することによってゲート電極2とストレージキャパシタ電極3にセルフアラインして第1のレジスト膜7₁、7₂を残す。

【0020】第2工程(図1(B)参照)

第1工程で形成した第1のフォトレジスト膜7₁、7₂をマスクにしてSiN膜6を選択的にエッチングしてチャネル保護膜6₁を形成し、その上に、n⁺a-Si膜、Cr膜を形成し、このn⁺a-Si膜、Cr膜をパターニングして、半導体活性層であるa-Si膜5₁、オーミックコンタクト層であるn⁺a-Si膜10₁、10₂、ソース電極11₁とドレイン電極11₂を形成し、ストレージキャパシタ電極3の上に、a-Si膜5₂とSiN膜6₂の積層体を形成する。

【0021】その上の全面に保護膜となるSiN膜13を形成し、このSiN膜13にソース電極11₁に達するコンタクトホール13₁と、ストレージキャパシタ電極3上のa-Si膜5₂に達するコンタクトホール13₂を形成する。その上にITO膜14を形成し、パター

ニングして、ストレージキャパシタ電極3の上に画素電極を形成し、画素電極とソース電極11₁を接続する配線を形成する。

【0022】本発明においては、この第2工程において、ストレージキャパシタ電極3上のコンタクトホール13₂をエッチングによって形成する際、a-Si膜5₂がエッチングストッパーとなり、余分のゲート絶縁膜4がエッチングされることがないため、膜厚の制御性がよくなる。したがって、ストレージキャパシタのばらつきが小さくなり、液晶表示装置の表示むらが無くなり、表示品質が向上する。

【0023】

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。図2、図3、図4は、本発明の一実施例の薄膜トランジスタマトリクス製造工程説明図で(A)～(H)は各工程を示している。この図において、1は透明なガラス基板、2はゲート電極、3はストレージキャパシタ電極、4はSiN膜、5はa-Si膜、5₁、5₂はa-Si膜、6はSiN膜、6₂はSiN膜、7₁、7₂は第1のレジスト膜、8₁、8₂は遮光膜、9は露光マスク、6₁はチャンネル保護膜、10、10₁、10₂はn⁺a-Si膜、11はCr膜、11₁はソース電極、11₂はドレイン電極、12₁、12₂は第2のレジスト膜、13はSiN膜、13₁、13₂はコンタクトホール、14はITO膜である。この製造工程説明図によって本発明の一実施例の薄膜トランジスタの製造方法を説明する。

【0024】第1工程(図2(A)参照)

透明なガラス基板1の上にAl/Ti膜を形成し、ゲート電極2とゲートバスライン(以下「ゲート電極2」で代表させる)とストレージキャパシタ電極3、ストレージキャパシタバスライン(以下「ストレージキャパシタ電極3」で代表させる)を形成する。

【0025】第2工程(図2(B)参照)

その上にP-CVDによって、ゲート絶縁膜となる厚さ400nmのSiN膜4、半導体活性層となる厚さ10nmのa-Si膜5、チャンネル保護膜となる厚さ10nmのSiN膜6を連続的に形成する。

【0026】第3工程(図2(C)参照)

第2工程で形成したチャンネル保護膜であるSiN膜4、活性層であるa-Si膜5、チャンネル保護層であるSiN膜6の上に、フォトリソ膜を形成し、このフォトリソ膜を、ガラス基板1の下からゲート電極2とストレージキャパシタ電極3をマスクにして背面露光し、また、ガラス基板1の上から、ゲート電極2の上に遮光膜8₁と、ストレージキャパシタ電極3の上に遮光膜8₂を有する露光マスク9を用いて正面露光し、現像することによってゲート電極2とストレージキャパシタ電極3にセルフアラインして第1のレジスト膜7₁、7₂を残す。

【0027】このように、従来の薄膜トランジスタの製

造方法では、SiN膜36をパターニングしてチャンネル保護膜36₁を形成する際、ゲート電極32とストレージキャパシタ電極33をマスクとする背面露光と、ゲート電極32の上方に遮光膜38を有する露光マスク39を用いて正面露光することによって、チャンネル保護膜36₁を形成する部分だけに第1のレジスト膜37が残るような露光を施したが(図6(C)参照)、この実施例では、この正面露光のフォトマスク9を一部変更して、ストレージキャパシタ電極3の上にもレジスト膜7₂を残す。

【0028】第4工程(図3(D)参照)

第3工程で形成した第1のフォトリソ膜7₁、7₂をマスクにしてSiN膜6を選択的にエッチングしてチャンネル保護膜6₁を形成する。その上に、オーミックコンタクト層となるn⁺a-Si膜10、ソース電極とドレイン電極となるCr膜11を形成する。

【0029】第5工程(図3(E)参照)

第4工程で形成したn⁺a-Si膜10、Cr膜11の全面にフォトリソ膜を形成し、ソース電極とドレイン電極の形状にパターニングした第2のレジスト膜12₁、12₂を残す。

【0030】第6工程(図7(F)参照)

第5工程で形成した第2のレジスト膜12₁、12₂をマスクにしてプラズマエッチングすることにより、Cr膜11とn⁺a-Si膜10とa-Si膜5を順次エッチング除去して、ゲート絶縁膜であるSiN膜4の上に、半導体活性層であるa-Si膜5₁、オーミックコンタクト層であるn⁺a-Si膜10₁、10₂、ソース電極11₁とドレイン電極11₂を形成し、ストレージキャパシタ電極3の上に、a-Si膜5₂とSiN膜6₂の積層体を形成する。

【0031】第7工程(図4(G)参照)

第6工程で形成したソース電極11₁とドレイン電極11₂、ストレージキャパシタ電極3上のa-Si膜5₂とSiN膜6₂の積層体を含むSiN膜4の全面に保護膜となるSiN膜13をP-CVDによって形成し、このSiN膜13を選択的にエッチングしてソース電極11₁に達するコンタクトホール13₁と、ストレージキャパシタ電極3上のa-Si膜5₂に達するコンタクトホール13₂を形成する。この工程において、ストレージキャパシタ電極3上のコンタクトホール13₂をエッチングによって形成する際、a-Si膜5₂がエッチングストッパーとなり、余分のゲート絶縁膜4がエッチングされることがなくなる。

【0032】第8工程(図4(H)参照)

第7工程で形成したコンタクトホール13₁、13₂を含むSiN膜13の全面にITO膜14をスパッタによって形成し、パターニングして、ストレージキャパシタ電極3の上に画素電極を形成し、画素電極とソース電極11₁を接続する配線を形成する。

【0033】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、チャンネル保護層であるSiN膜6をパターンニングする際に用いるフォトリソ膜を正面露光するときの露光マスクを一部変更するだけで、ストレージキャパシタの容量のバラツキを均一化することができ、液晶表示面の表示むらを解消し、表示品質を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の薄膜トランジスタマトリクス of 製造方法の原理説明図であり、(A)と(B)は各工程を示している。

【図2】本発明の一実施例の薄膜トランジスタマトリクス of 製造工程説明図(1)であり、(A)～(C)は各工程を示している。

【図3】本発明の一実施例の薄膜トランジスタマトリクス of 製造工程説明図(2)であり、(D)～(F)は各工程を示している。

【図4】本発明の一実施例の薄膜トランジスタマトリクス of 製造工程説明図(3)であり、(G)、(H)は各工程を示している。

【図5】従来の薄膜トランジスタマトリクス of TFT基板の平面図である。

【図6】従来の薄膜トランジスタマトリクス of 製造工程説明図(1)であり、(A)～(C)は各工程を示している。

【図7】従来の薄膜トランジスタマトリクス of 製造工程

説明図(2)であり、(D)～(F)は各工程を示している。

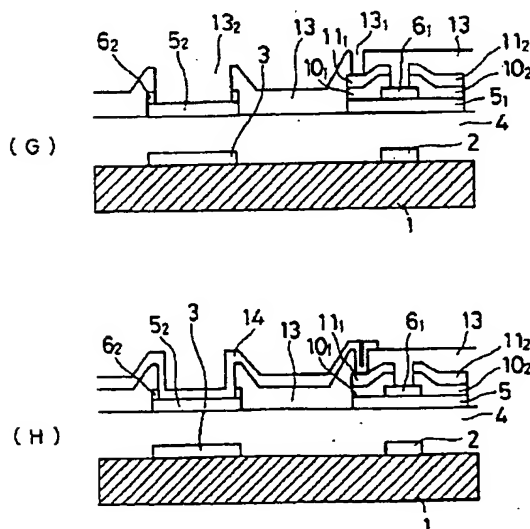
【図8】従来の薄膜トランジスタマトリクス of 製造工程説明図(3)であり、(G)、(H)は各工程を示している。

【符号の説明】

- 1 透明なガラス基板
- 2 ゲート電極
- 3 ストレージキャパシタ電極
- 4 SiN膜
- 5 a-Si膜
- 5₁, 5₂ a-Si膜
- 6 SiN膜
- 6₂ SiN膜
- 7₁, 7₂ 第1のレジスト膜
- 8₁, 8₂ 遮光膜
- 9 露光マスク
- 6₁ チャンネル保護膜
- 10, 10₁, 10₂ n⁺a-Si膜
- 11 Cr膜
- 11₁ ソース電極
- 11₂ ドレイン電極
- 12₁, 12₂ 第2のレジスト膜
- 13 SiN膜
- 13₁, 13₂ コンタクトホール
- 14 ITO膜

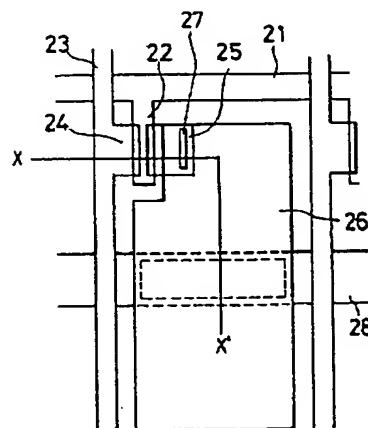
【図4】

本発明の一実施例の薄膜トランジスタマトリクス of 製造工程説明図(3)



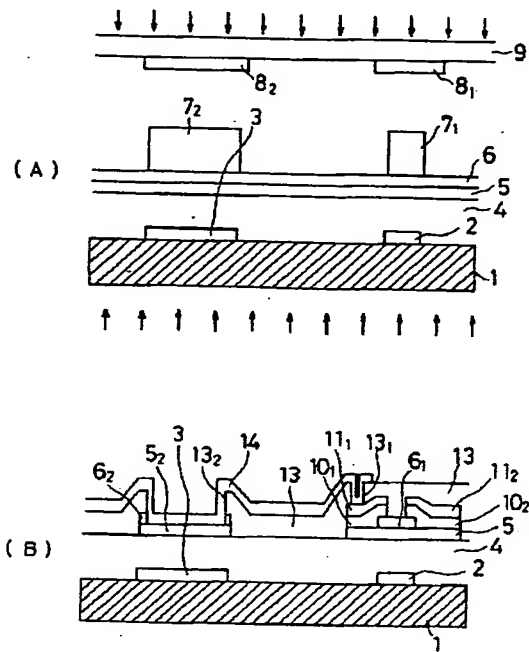
【図5】

従来の薄膜トランジスタマトリクス of TFT基板の平面図



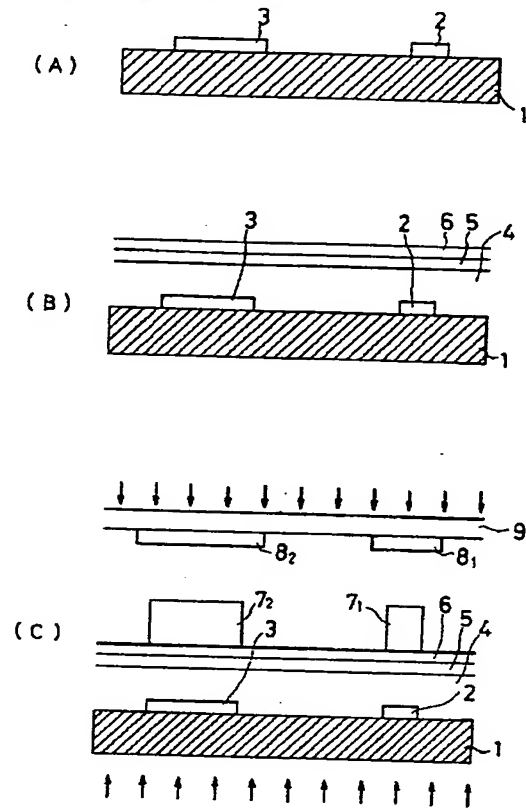
【図1】

本発明の薄膜トランジスタマトリクス製造方法の原理説明図



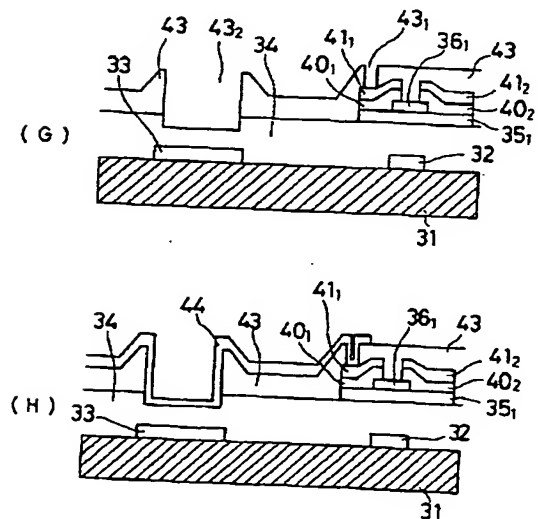
【図2】

本発明の実施例の薄膜トランジスタマトリクス製造工程説明図(1)



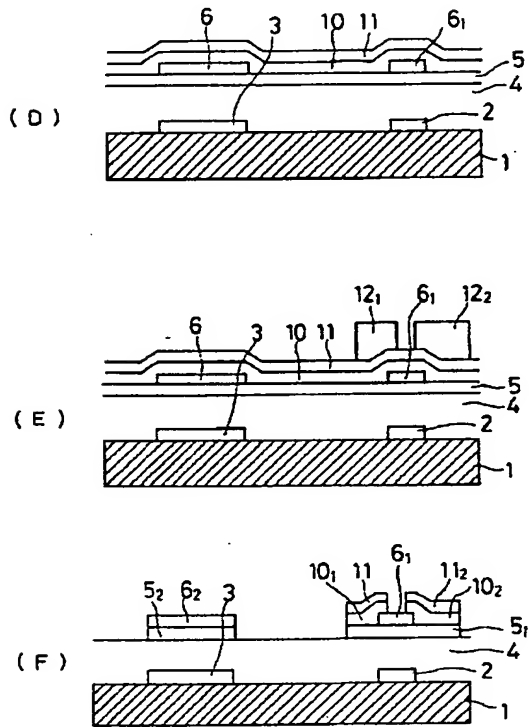
【図8】

従来の薄膜トランジスタマトリクス製造工程説明図(3)



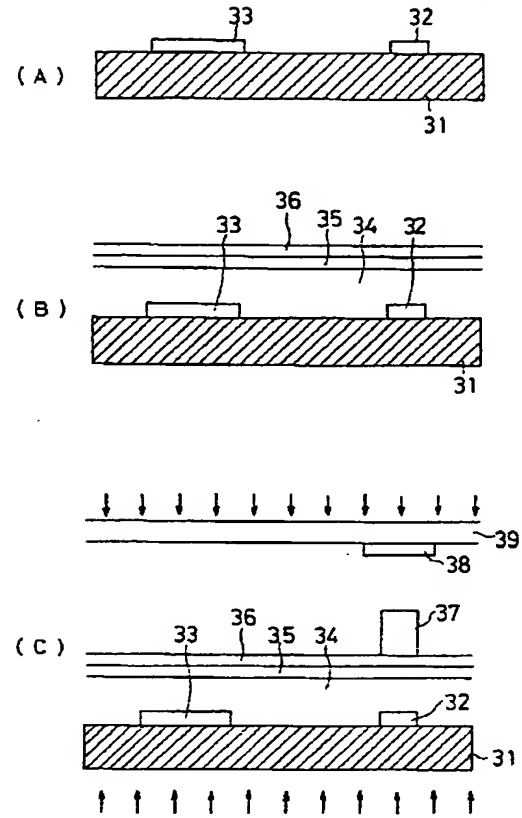
【図3】

本発明の実施例の薄膜トランジスタマトリクス
製造工程説明図(2)



【図6】

従来の薄膜トランジスタマトリクスの製造工程説明図(1)



【図7】

従来の薄膜トランジスタマトリクス製造工程説明図(2)

